

KPT081M32

Codice prodotto: KPT081M32

Produttore: Kyosemi Corporation

Caratteristiche:

- NPN fototransistor
- Invasatura epossidica trasparente
- Bassa corrente di perdita

Applicazioni:

- Switch ottici
- Encoder ottici
- Photo-isolator
- Sensori infrarossi
- Apparato di controllo automatico

Half Angle (deg)	90
Package	φ3 plastic mold
Peak sens. wavelenght (nm)	800
Photo Current Vce = 5 V	4 (mA) 1000 (Ix)
Sensitive Area (mm)	0.64 x 0.64
Tipologia	Silicon Phototransistors